به نام خدا

الكترونيك ٢

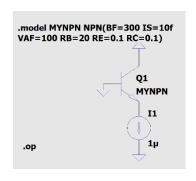
پروژه ۱

على كوچك زاده (۴۰۰۱۰۱۸۳۷)

شهناز پوربرقی (۴۰۰۱۰۰۸۷۶)

۱ ـ ابتدا VBE و (VCE(sat را برای ترانزیستور NPN بدست می آوریم.

برای اینکار مدار زیر را در SPICE شبیه سازی میکنیم و به کمک آن ولتاژ VBE را بدست می آوریم.

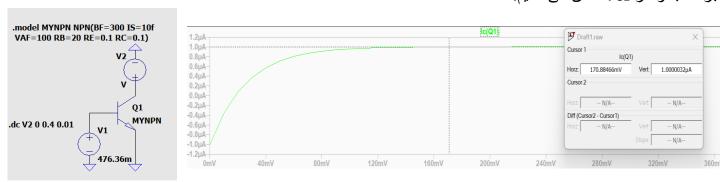


#### --- Operating Point ---

V(n001): -0.476364 voltage
Ic(Q1): 9.96677e-007 device\_current
Ib(Q1): 3.32273e-009 device\_current
Ie(Q1): -1e-006 device\_current
I(II): 1e-006 device\_current

برای مثال در شکل بالا ولتاژ VBE را برای جریان Ic=1uA را بدست آوردیم که برابر 476.36mV است. به طور مشابه برای بقیه جریان کار هم این ولتاژ را بدست می آوریم و در جدول می نویسیم.

سپس برای بدست آورن ولتاژ (VCE(sat) از مدار زیر استفاده می کنیم و چون ولتاژ VBE را داریم پس نمودار جریان Ic را برحسب ولتاژ VCE نشان می دهیم.

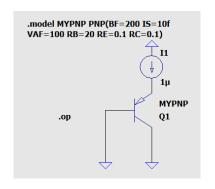


همانطور که در شکل بالا مشخص است برای جریان Ic=1uA ولتاژ (VCE(sat) برابر 170.89mV میباشد. برای بقیه جریان های Ic روند مشابه را تکرار می کنیم و در جدول می نویسم.

Ic	1uA	10uA	100uA	1mA	10mA
VBE(on)	476.36mV	535.92mV	595.49mV	655.20mV	716.25mV
VCE(sat)	170.89mV	182.35mV	188.20mV	195.39mV	213.82mV

اكنون VBE و (VCE(sat) را براى ترانزيستور PNP بدست مى آوريم.

برای بدست آوردن ولتاژ VBE مدار زیر را در SPICE استفاده می کنیم و داریم:

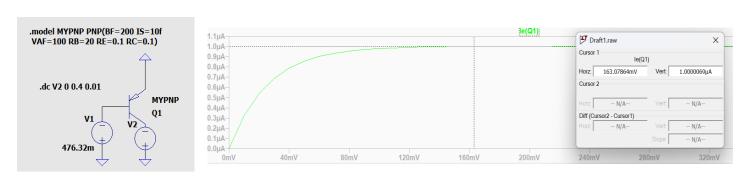


### --- Operating Point ---

V(n001): 0.476321 voltage
Ic(Q1): -9.95024e-007 device\_current
Ib(Q1): -4.9756e-009 device\_current
Ie(Q1): 1e-006 device\_current
I(I1): 1e-006 device\_current

برای مثال در شکل بالا ولتاژ VBE را برای جریان Ic=1uA را بدست آوردیم که برابر 476.32mV- است. به طور مشابه برای بقیه جریان کار هم این ولتاژ را بدست می آوریم و در جدول می نویسیم.

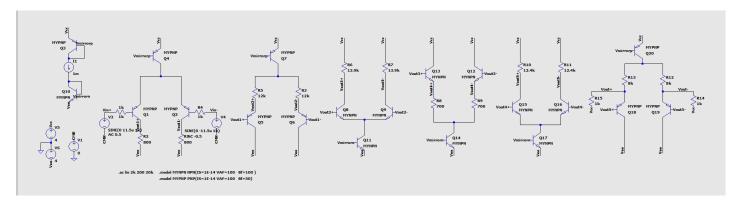
سپس برای بدست آورن ولتاژ (VCE(sat) از مدار زیر استفاده می کنیم و چون ولتاژ VBE را داریم پس نمودار جریان Ic را برحسب ولتاژ VCE نشان می دهیم.



همانطور که در شکل بالا مشخص است برای جریان Ic=1uA و لتاژ (VCE(sat) برابر 163.07mV میباشد. برای بقیه جریان های Ic روند مشابه را تکرار می کنیم و در جدول می نویسم.

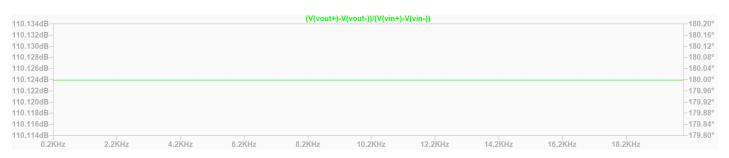
Ic	1uA	10uA	100uA	1mA	10mA
VBE(on)	476.32mV	535.88mV	595.45mV	655.19mV	716.54mV
VCE(sat)	163.07mV	177.21mV	188.59mV	193.73mV	205.57mV

## ۲ ـ تقویت کننده زیر را طراحی میکنیم و در SPICE شبیه سازی می کنیم.



## برای تحلیل DC داریم:

## گین دیفر انسیلی مدار بر ابر است با



# گین مد مشترک مدار برابر است با



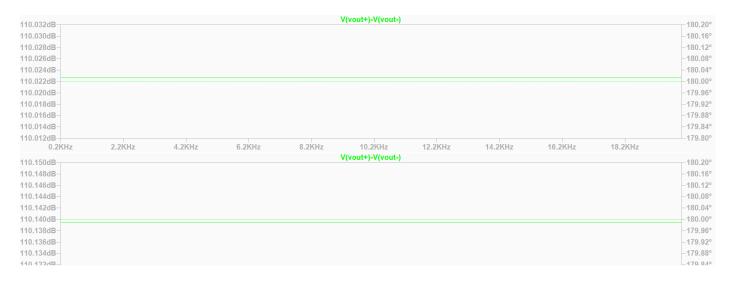
### برای ورودی 0 خروجی برابر است با



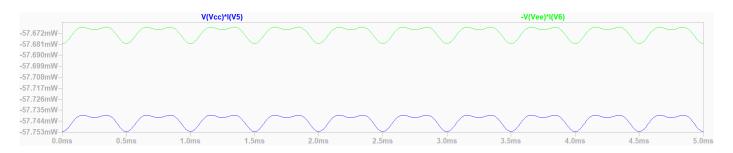
## سویینگ مدار بر ابر است با



## یک بار ورودی مد مشترک مدار را 2.5 و یک بار 4- قرار می دهیم و بهره مدار برابر است با



توان مصرفی مدار برابر است با مجموع توان تولید شده توسط منبع ولتاژ های Vcc و VEE

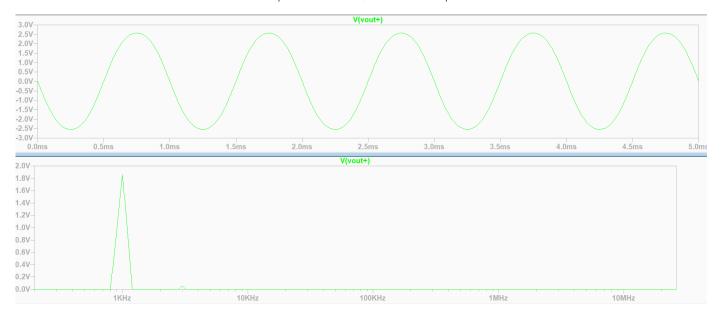


روش طراحی: طراحی کلی مدار به این صورت است که از بار مقاومتی استفاده شده است و دارای ۳ طبقه گین و ۳ طبقه بافر است و یک منبع جریان ایده آل ۱ میلی آمپری داریم که از آن کپی میگیریم در نتیجه جریان کار های مدار برابر نیم میلی آمپر میباشد.

در طبقه اول از طبقه گین استفاده شده است و برای اینکه بتواند از ورودی مشترک 4- تا 2.5 ولت پشتیبانی کند پس حتما باید از PNP استفاده شود. در نتیجه تغییرات بیس ،تغییرات امیتر برابر است با 3.3- تا 3.2 ولت و چون امیتر باید حداقل 0.2 ولت از کالکتور بیشتر باشد پس ولتاژ کالکتور را 3.6- ولت درنظر میگیریم تا از اشباع نشدن ترانزیستور مطمئن شویم پس یک مقاومت ۸۰۰ اهمی در کالکتور طبقه اول قرار میگیرد و درنتیجه ولتاژ این نقطه نیز در 3.6- ولت ثابت می شود.

در طبقه دوم و ششم از یک یک بافر PNP استفاده می کنیم تا طبقه های گین لود نشود در طبقه سوم و پنجم از یک مدار گین NPN استفاده می کنیم.

## ۳ ـ سویینگ مدار را روی 5 ولت قرار میدهیم و از خروجی FFT میگیریم



در شکل موج تولید شده فقط هار مونیک ۳ ام موجود است.

$$THD = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots}}{V_1} = \frac{\sqrt{52.9m^2}}{1831m} = 0.0289 = 2.89\%$$